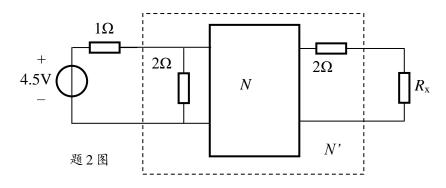
电路原理期中考试试题 2018.04.14

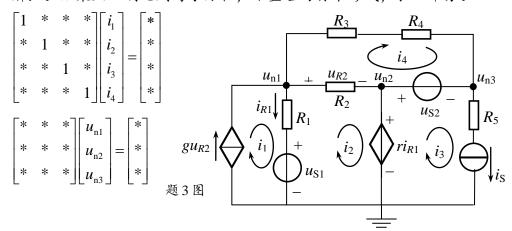
所有电压电流参考方向可标在试题纸上。 不用在答题纸上抄题和重画电路。 最终试题纸、答题纸均上交。

	姓名:		班级		学号		
1. 填	空。(25分。	每空1分。	在答题纸上	作答,在试	题纸上的回	答不计成	<u>绩</u>)
(1)	无论是线性	电阻, 还是	非线性电阻,	其 u-i 特性	曲线一定过	原点。()
	(填"对"或	"错")					
(2)	非时变电路	的响应与激	励施加的时刻	〕无关。() (填"	对"或"错'	')
(3)	压控电流源	的输入电阻	为(),	输出电阻为	();	流控电压	玉源的
	输入电阻为	(),	输出电阻为	() 。			
(4)	替代定理只	适用于线性	电路。() (均	真"对"或"错'	")	
(5)	一个有 b 条	支路、n个节	点的电路,其	独立节点电	压方程的个	数为(),
	独立回路电	流方程的个	数为() 。			
(6)	对于不含受	控源的电路	,其标准形式	飞的节点电 <i>压</i>	玉方程中,プ	方程左边系	系数矩
	阵的对角线	元素称为(),其	物理意义为	();	非对角组	戈元素
	称为(),其值一定	为()(填'	'正"或"负")	, 其物理意	义为()。
(7)	对于不含受	控源的电路	,其标准形式	式的回路电流	充方程中,プ	方程左边系	系数矩
	阵的对角线	元素称为(),其	·物理意义为	();	非对
	角线元素称	为(), 其物.	理意义为() 。	
(8)	理想运放满	足"虚短"和	"虚断"的特性	() (填'	<mark>'对"或"错</mark>	<mark>")</mark>
(9)	互易二端口	网络的传输	参数满足(), 🛪	付称二端口	1网络
	的传输参数	满足() 。			
(10)	n 沟道增强	展型 MOSFE	Γ的 D-S 之间	表现为电阻	L的条件是	(),
	该情况通常	用于分析由	MOSFET 构	战的()(填"	数字"或"标	莫拟")
	电路; D-S	之间表现为	压控电流源的	的条件是(),该情	青况通
	常用于分析	由 MOSFET	'构成的() ((填"数字"或	"模拟")	电路。
					Гэ	1007	
2. (15分) 题图	所示电路中	二端口网络	V 的 T 参数:	矩阵为	10Ω	
					1.58	6	

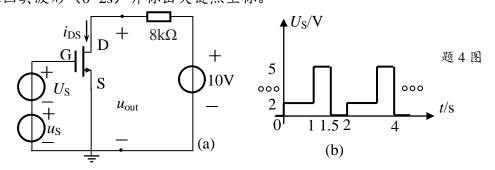
- (1) 将虚线框内视作一个新的二端口网络 N', 求 N'的 T 参数矩阵。
- (2) 电阻 R_x 为何值时其获得最大功率,最大功率为多少?



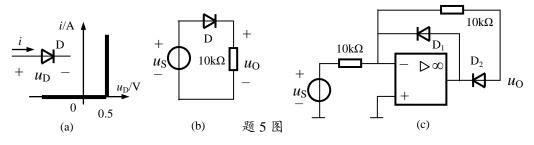
3. (20分)按题图中给出的节点电压和回路电流编号,列写该电路的节点电压 方程和回路电流方程,消除中间变量,整理成如下所示的标准形式(无需求 解)。如果只正确地列写了方程,不整理为标准形式,扣一半分。



4. (15 分)题图(a)所示电路中的 n 沟道增强型 MOSFET 如果工作在电阻区, $R_{\rm ON}=2{\rm k}\Omega$; 如果工作在压控电流源区, $i_{\rm DS}=\frac{K\left(u_{\rm GS}-U_{\rm T}\right)^2}{2}$, 其中 $U_{\rm T}=1{\rm V}$, $K=0.5{\rm mA/V}^2$; $u_{\rm S}=10{\rm sin}(\pi t)$ mV; $U_{\rm S}$ 如题图(b)所示。求题图(a)中的电压 $u_{\rm out}$,定性画其波形(0~2s)并标出关键点坐标。



5. (15分)本题中所有二极管 D 的模型均如题图(a)所示。在题图(b)和(c)中,电压 u_s =2sin(t) V。题图(c)中的理想运放满足"虚短"和"虚短"。(1)求题图(b)中的电压 u_o ,在同一张示意图中画出 u_o 和 u_s 波形,该电路实现了怎样的功能?(2)求题图(c)中的电压 u_o ,在同一张示意图中画出 u_o 和 u_s 波形,该电路实现了怎样的功能?(3)题图(b)和(c)电路的功能有何区别?



题6图